

請求の範囲

- [請求項1] 支持フィルムと、前記支持フィルムの片面又は両面上に設けられた
接着層と、を備え、リードフレームのダイパッドに搭載された半導体
素子を封止する封止層を形成する封止成形の間、前記リードフレーム
の前記半導体素子とは反対側の面を仮保護するために用いられる、半
導体封止成形用仮保護フィルムであって、
前記接着層が、
熱可塑性樹脂と、
ソルビトールポリグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジ
グリシジルエーテル、炭素数10～20の脂肪族アルコールのグリシ
ジルエーテル、グリセロールポリグリシジルエーテル、炭素数2～3
0の脂肪酸のポリアルキレングリコールエステル、炭素数2～20の
脂肪酸のジペンタエリスリトールエステル、ポリエチレングリコール
モノアルキルエーテル、及びポリエチレングリコールジアルキルエー
テルからなる群より選ばれる少なくとも一種の特定化合物を含む、半
導体封止成形用仮保護フィルム。
- [請求項2] 前記熱可塑性樹脂が、芳香族ポリエーテルアミドイミド、芳香族ポ
リエーテルイミド、芳香族ポリエーテルアミド、芳香族ポリアミド、
芳香族ポリエステル、芳香族ポリイミド、芳香族ポリアミドイミド、
芳香族ポリエーテル、及び芳香族ポリエステルイミドからなる群より
選ばれる少なくとも1種を含む、請求項1に記載の半導体封止成形用
仮保護フィルム。
- [請求項3] 前記特定化合物の含有量が、前記熱可塑性樹脂の含有量100質量
部に対して5～30質量部である、請求項1又は2に記載の半導体封
止成形用仮保護フィルム。
- [請求項4] ダイパッドを有するリードフレームと、
請求項1～3のいずれか一項に記載の半導体封止成形用仮保護フ
ィルムと、

を備え、

前記仮保護フィルムが、前記リードフレームの一方の面に、前記仮保護フィルムの接着層が前記リードフレームと接する向きで貼り付けられている、仮保護フィルム付きリードフレーム。

[請求項5]

ダイパッドを有するリードフレームと、

前記リードフレームの一方の面側において前記ダイパッドに搭載された半導体素子と、

前記半導体素子を封止している封止層と、

請求項1～3のいずれか一項に記載の半導体封止成形用仮保護フィルムと、

を備え、

前記仮保護フィルムが、前記リードフレームの前記半導体素子とは反対側の面に、前記仮保護フィルムの接着層が前記リードフレームと接する向きで貼り付けられている、仮保護された封止成形体。

[請求項6]

ダイパッドを有するリードフレームの一方の面に、請求項1～3のいずれか一項に記載の半導体封止成形用仮保護フィルムを、その接着層が前記リードフレームに接する向きで貼り付ける工程と、

前記ダイパッドの前記仮保護フィルムとは反対側の面上に半導体素子を搭載する工程と、

前記半導体素子を封止する封止層を形成して、前記リードフレーム、前記半導体素子及び前記封止層を有する、仮保護された封止成形体を得る工程と、

前記封止成形体から前記仮保護フィルムを剥離する工程と、

をこの順に備える、半導体パッケージを製造する方法。

[請求項7]

前記リードフレームが複数の前記ダイパッドを有し、前記複数のダイパッドの各々に前記半導体素子が搭載され、

当該方法が、前記仮保護フィルムを前記封止成形体から剥離した後、前記封止成形体を分割して、1個の前記ダイパッド及び前記半導体

素子を有する半導体パッケージを得る工程を更に備える、請求項 6 に記載の方法。